

ЦИКЛОТРОННО-ВОЛНОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕТАЛЛОВ

А.Ю. Романов, В.П. Силин

УДК 538.569

Исследовано влияние непарabolических участков поверхности Ферми на возбуждение ферми-жидкостных циклотронных доплеронов в металлах.

Для экспериментального наблюдения предсказанных в /1/ циклотронных доплеронов (ЦД) (см. также /2/) необходимо развитие теории, позволяющей выявить свойства металлов не только способствующие такому наблюдению, но и затрудняющие его. Распространяющиеся вдоль магнитного поля ЦД обусловлены особыми участками поверхности Ферми /1,2/. Кроме того, для наблюдения ЦД, по-видимому, необходимо исследовать резонансное прохождение электромагнитного поля /3/. В этой связи в /4/ была построена теория прохождения излучения через металлическую пластину в условиях частично диффузного отражения электронов от границ металла в предположении, что поверхность Ферми электронов является параболоидом вращения. Недостаточная общность модели работы /4/ связана с пренебрежением электронами других участков поверхности Ферми, которые могут определять структуру поля в металле в условиях аномального скин-эффекта. Поэтому в настоящем сообщении мы используем расширенную модель, в которой помимо вклада параболоидных участков учитывается также вклад сферической поверхности Ферми. В соответствии с этим для объемной проводимости σ_N имеем $\sigma_N = \sigma_N^{(p)} + \sigma_N^{(s)}$, где

$$\sigma_N^{(p)} = i\eta \frac{\sigma_H^{(p)}}{\kappa} \frac{\kappa^2 k^2 - q_N^2 d_p^2 \kappa_0^2}{(\kappa^2 - q_N^2 d_p^2)(k^2 - q_N^2 d_p^2)} ; \quad \sigma_N^{(s)} = \frac{3}{4} \pi \eta \frac{\sigma_H^{(s)}}{q_N d_s} ;$$
$$d_s \gg d_p; \quad m_s \gg m_p.$$

Здесь N — целые числа; $\eta = \pm 1$ соответствует правой и левой поляризации

излучения с частотой ω ; $\sigma_H = \text{enc}/B$; $d_N = \pi N/L$; L – толщина пластины; $d_p = v_p/\Omega_p$ (ср. /3/); $d_s = v_s/\Omega_s$; $\kappa = 1 + \eta(\omega/\Omega_p + i\nu_p/\Omega_p)$; $\hat{k}^2 = \kappa^2 - \eta\kappa Y_2$; $\kappa_0^2 = \kappa^2 - (1 - r)\eta\kappa Y_2$; $Y_2 = A_2 \omega / (1 + A_2) \Omega_p^2$; A_2 – параметр ферми-жидкостного взаимодействия; r – постоянная, введенная в /4/; v_s – фермиевская скорость сферического участка.

Коэффициент диффузного рассеяния p_s носителей на сферическом участке ферми-поверхности можно считать малым по сравнению с соответствующим коэффициентом p_p параболоидных носителей. Приняв $n_p p_p d_p \gg n_s p_s d_s$, будем учитывать только вклад параболоидных участков в поверхностную проводимость, выражение для которого было приведено в /4/ при последовательном учете междуэлектронного взаимодействия. Следуя методу работы /5/, получаем (ср. /4/) для импеданса при антисимметричном (a) и симметричном (s) возбуждении

$$Z/Z_0 = X - \xi \rho \kappa^2 [r Y^2 + (1 - r) (\hat{k}/\kappa)^4 U^2 + \xi \rho \kappa^2 r (1 - r) (\hat{k}/\kappa)^4 (Y^2 W - 2YUR + t_s U^2 V)] [1 + \xi \rho \kappa^2 (rV + (1 - r) (\hat{k}/\kappa)^4 W) + \xi^2 \rho^2 \hat{k}^4 r (1 - r) (VW - R^2)]^{-1}. \quad (1)$$

Здесь $Z_0 = 2\pi\omega d_p/c^2$; $\xi = 4\pi\omega\sigma_H^{(p)} d_p^2/c^2$; $\rho = p_p/(2 - p_p)$; $X^{(a)} \dots R^{(a)} = (2i/\pi) \sum_{i=1}^7 A_i^{X\dots R} \Phi^{(s)}(-\kappa_i L/2\pi d_p)$; $A_i^X = A_i$; $A_i^Y = A_i/\beta_i$; $A_i^U = A_i/\beta_i^2$; $A_i^R = A_i/\beta_i\hat{\beta}_i$; $A_i^V = A_i/\beta_i^2$; $A_i^W = A_i/\hat{\beta}_i^2$; $A_i = \kappa_i \beta_i \hat{\beta}_i \prod_{j \neq i=1}^7 (\kappa_i - \kappa_j)$; $\beta_i = \kappa^2 - \kappa_i^2$;

$$\hat{\beta}_i = \hat{k}^2 - \kappa_i^2; \Phi^{(a)}(x) = \psi(x + 1/2); \Phi^{(s)}(x) = \psi(x) + 1/2x,$$

где $\psi(x)$ – логарифмическая производная гамма-функции.

Имея в виду $\xi \gg 1$ и $D \equiv d_s n_p / d_p n_s \gg 1$, можно записать в аналитическом виде все семь корней дисперсионного уравнения волн, определяющегося объемной проводимостью. Поэтому для вычисления (1) с точностью до членов, пропорциональных ξ^{-1} и D^0 , суммы по корням дисперсионного уравнения можно представить в виде

$$X \frac{\omega d_p}{v_s} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \frac{1 - i\sqrt{3}}{(\pi\xi_0)^{1/3}} + \frac{16}{27} \frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{3}\pi} \frac{\Delta_2}{\eta\omega} \frac{v_s}{v_p} \frac{D}{(\pi\xi_0)^{2/3}} - \frac{16}{9\pi^2} \times$$

$$\begin{aligned}
& \times \frac{\Delta_2^2}{\omega^2} \frac{v_s^2}{v_p^2} \frac{D^2}{\pi \xi_0} \left[C - \frac{1}{\pi} - \frac{9\pi}{8D^2} \frac{\Delta_0}{\Delta_2^3} (\Delta_0 \Delta_1 - \Delta_0 \Delta_2 - \Delta_1 \Delta_2) \right], \\
Y &= - \frac{C}{\pi \xi_0} \frac{v_s^3}{d_p^3 \omega^3} + \frac{a_6}{\beta_6} s_6, U = - \frac{C}{\pi \xi_0} \frac{v_s^3}{d_p^3 \omega^3} + \frac{a_6}{\beta_6} s_6, R = \frac{a_6}{\beta_6 \beta_6} s_6, \\
V &= \frac{a_6}{\beta_6^2} s_6, W = \frac{a_6}{\beta_6^2} s_6, a_6 = - \frac{3\beta_6 \hat{\beta}_6 v_s^3 \Omega_p^2}{4d_p^3 \omega^3 \xi_0 D \Delta_0 \sqrt{\Delta_1 \Delta_2}}, \beta_6 = \frac{\Delta_0^2 (\Delta_2 - \Delta_1)}{\Delta_2 \Omega_p^2}, \\
\hat{\beta}_6 &= \frac{\Delta_1 \Delta_0 (\Delta_2 - \Delta_0)}{\Delta_2 \Omega_p^2}, C = \frac{2}{\pi} \ln \left[\frac{3\pi}{4} \frac{(\pi \xi_0)^{1/3}}{D} \frac{\omega v_p}{\Delta_2 v_s} \right] - \frac{i}{3}, \Delta_0 = \eta \Omega_p + \omega + \\
&+ i\nu_p, \Delta_1 = \eta \Omega_p + \omega/(1 + A_2) + i\nu_p, \Delta_2 = \eta \Omega_p + \omega(1 + rA_2)/(1 + A_2) + i\nu_p, \\
s_6^{(a)} &= -i \operatorname{tg}(kL/2), s_6^{(s)} = i \operatorname{ctg}(kL/2), k = \eta(\Delta_0/v_p) \sqrt{\Delta_1/\Delta_2},
\end{aligned}$$

где k – комплексный волновой вектор ЦД; $\xi_0 = 3\omega_p^{(s)^2} v_s^2 / 4\omega^2 c^2 \gg 1$ – не зависящий от магнитного поля параметр аномальности скин-эффекта.

Эти формулы позволяют записать следующее выражение для импеданса Z пластины металла, находящейся в перпендикулярном поле:

$$\begin{aligned}
\frac{Zc^2}{2\pi v_s} &= \frac{\omega d_p}{v_s} X - \frac{4}{3\pi} \rho \frac{\Delta_0^2 \Delta_2}{\omega^2} \frac{v_s^2}{v_p^2} \frac{DC}{\pi \xi_0} \left[C \left(r + (1-r) \frac{\Delta_1^2}{\Delta_0^2} + \right. \right. \\
&\left. \left. + \eta \rho s_6 \frac{\Delta_1^{1/2} \Delta_2^{3/2}}{\Delta_0^2} \right) - \frac{3\pi}{2} r(1-r) \frac{s_6}{D} \left(\frac{A_2}{1+A_2} \right)^2 - \frac{\omega^2 \Delta_1^{1/2}}{\Delta_2^{3/2} \Delta_0} \right] X \\
&\times (\Delta_2 + \eta \rho s_6 \sqrt{\Delta_1 \Delta_2})^{-1}.
\end{aligned} \tag{2}$$

Старший член в правой части (2) содержится в X и обусловлен только электронами сферической поверхности. Остальные обусловлены вкладами обоих сортов носителей. Резонансный знаменатель последнего слагаемого правой части (2) отвечает вкладу только параболоидных участков, которые определяют дисперсионное уравнение ЦД.

В результате для коэффициента прохождения получаем следующее выражение:

$$\begin{aligned}
T = & \frac{4}{3\pi} \rho \frac{v_s}{c} \frac{\Delta_0^2}{\omega^2} \frac{v_s^2}{v_p^2} \frac{DC}{\pi\xi_0} \left[2ir(1-r) \left(\frac{A_2}{1+A_2} \right)^2 - \frac{\Delta_1^{1/2} \omega^2}{\Delta_2^{1/2} \Delta_0^2} \left[\frac{3\pi}{2} \times \right. \right. \\
& \times \left. \left. \frac{1}{D} \left(\frac{\Delta_0}{\Delta_2} + \eta\rho C \right) \right] + \frac{9\pi}{8D^2} \left(\frac{\pi d_p}{L} \right)^2 \frac{\Omega_p^2}{\Delta_2^2} \left(r + (1-r) \frac{\Delta_1^2}{\Delta_0^2} \right) \sin kL \right] \times \\
& \times [(1+\rho^2 \Delta_1/\Delta_2) \sin kL + 2i\eta\rho\sqrt{\Delta_1/\Delta_2} \cos kL]^{-1}.
\end{aligned}$$

Особый интерес представляет окрестность резонанса, когда частота и магнитное поле удовлетворяют дисперсионному уравнению ЦД /1/ с $q_N = k$. Если, кроме того, принять $\rho^2 \Delta_1 \ll \Delta_2$, $L \ll l_p$ (l_p – длина свободного пробега), то вблизи пика прохождения имеем ($k' = \operatorname{Re} k$):

$$\begin{aligned}
T = & \frac{8i}{3\pi} r(1-r)\rho \frac{v_s}{c} \sqrt{\frac{\Delta_1}{\Delta_2}} \frac{v_s^2}{v_p^2} \left(\frac{A_2}{1+A_2} \right)^2 \frac{DC}{\pi\xi_0} \left(\frac{3\pi}{2D} \frac{\Delta_0}{\Delta_2} + \eta\rho C \right) \times \\
& \times \left\{ k'L - \pi N + i\eta(-1)^N \sqrt{\frac{\Delta_1}{\Delta_2}} \left[\frac{L}{l_p} \left(1 + \frac{\Delta_0(\Delta_2 - \Delta_1)}{2\Delta_1\Delta_2} \right) + 2\rho \right] \right\}^{-1}.
\end{aligned}$$

При выводе (3) использовалось также неравенство $Dv_s \Delta_2 \ll \omega v_p \xi_0^{1/3}$, отвечающее тому, что вклад сферических носителей в импеданс является преобладающим (при этом $|C| \gg 1$).

При выполнении неравенства $DC\rho \gg 1$ имеем квадратичную зависимость коэффициента прохождения от ρ . Такая же зависимость ($\propto \rho^2$) была получена в /4/, когда не учитывались сферические участки поверхности Ферми. Однако наличие сферических участков поверхности Ферми при достаточно большом коэффициенте диффузности ухудшает прохождение ЦД. В этом случае отношение выражения (3) к коэффициенту прохождения, полученному в /4/, равно $(16/3\sqrt{3}\pi)C^2 [Dv_s \Delta_2/v_p \omega (\pi\xi_0)^{1/3}]^{3/2} \ll 1$.

Напротив, при малых ρ , когда $DC\rho \ll 1$, коэффициент прохождения линейно зависит от ρ . В этом случае отношение (3) к коэффициенту прохождения, полученному без учета сферических участков поверхности Ферми, равно

$-(8/\sqrt{3}\pi)[Dv_s\Delta_2/v_p\omega(\pi\xi_0)^{1/3}]^{3/2}C^2[\eta\Delta_0/\Delta_2\rho DC]$. Поэтому при низких частотах, когда $Cv_s^{3/2}D^{1/2}\Delta_2^{1/2}\Delta_0 \gg \xi_0^{1/2}\omega^{3/2}\rho v_p^{3/2}$, возможно увеличение прохождения ЦД за счет влияния сферических участков поверхности Ферми.

Поступила в редакцию 5 ноября 1984 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Романов А.Ю., Силин В.П. Краткие сообщения по физике ФИАН, № 5, 46 (1980).
2. Зимбовская Н.А. и др. ФНТ, 8, № 9, 930 (1982).
3. Романов А.Ю., Силин В.П. ФММ, 56, № 4, 639 (1983).
4. Зимбовская Н.А. и др. ФММ, 58, № 5, 851 (1984).
5. Окулов В.И., Устинов В.В. ФММ, 56, № 3, 421 (1983).